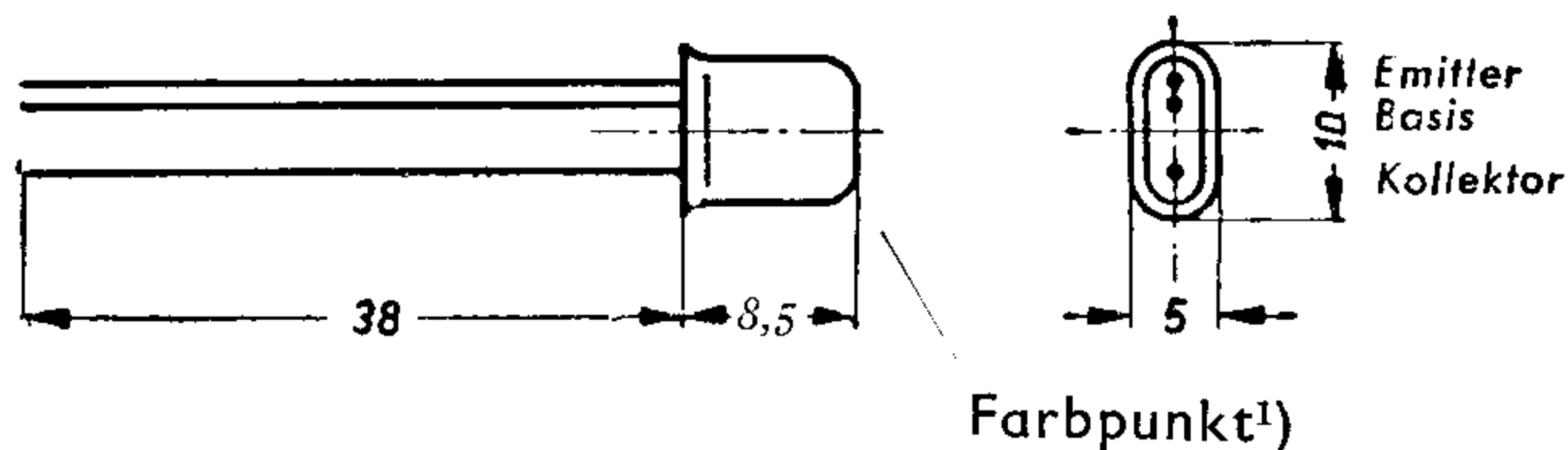


FLÄCHENTRANSISTOREN

Ausgabe: November 1957

OC 816
p-n-p-Flächentransistor
In Vorbereitung



Verwendung:

Der Transistor OC 816 ist geeignet für Endstufen kleiner Leistung, für Vorverstärkerstufen und Treiberstufen für Gegentaktendverstärker, z. B. für 2 OC 821.

Kennwerte:

Emitterschaltung gemessen bei

$\vartheta_{\alpha} = 25^{\circ} \text{ C}; -U_{CE} = 6 \text{ V} \quad -J_C = 2 \text{ mA}; f = 1 \text{ kHz}$

Kurzschluß-Eingangswiderstand $h'_{11} = 0,4 \dots 2 \text{ k}\Omega$

Leerlauf-Spannungsrückwirkung $h'_{12} = 4 \dots 25 \cdot 10^{-4}$

Kurzschluß-Stromverstärkung $h'_{21} = 20 \dots 100^1)$

Leerlauf-Ausgangsleitwert $h'_{22} = 20 \dots 150 \text{ }\mu\text{S}$

Leistungsverstärkung $G' = 32 \dots 45 \text{ dB}$

(bei $-U_{CE} = 6 \text{ V}; -J_C = 1 \text{ mA}; R_L = 50 \text{ k}\Omega$)

Rauschfaktor $F < 25 \text{ dB}$

(bei $-U_{CE} = 1 \text{ V}; -J_C = 1 \text{ mA}; R_g = 500 \text{ }\Omega, f = 1 \text{ kHz}$)

Grenzfrequenz $f_{\alpha} > 300 \text{ kHz}$

(gemessen in Basisschaltung bei $-U_{CB} = 6 \text{ V}; -J_C = 2 \text{ mA}$)

¹⁾ s. Seite 2

Änderungen vorbehalten

FLÄCHENTRANSISTOREN

Ausgabe: November 1957

OC 816 p-n-p-Flächentransistor In Vorbereitung

Maximalwerte:

Kollektorreststrom

bei $-U_{CB} = 6 \text{ V}$ $J_E = 0$: $-J_{co} \leq 20 \mu\text{A}$

bei $-U_{CE} = 6 \text{ V}$ $J_B = 0$: $-J'_{co} \leq 400 \mu\text{A}$

Kollektorrestspannung

bei $-J_c = 10 \text{ mA}$ $-U_R \leq 0,3 \text{ V}$

Kollektorspannung

$-U_{CEmax} = 10 \text{ V}$

Kollektorspitzenspannung

$-U_{CEsp} = 15 \text{ V}$

Kollektorstrom

$-J_{cmax} = 20 \text{ mA}$

Kollektorspitzenstrom

$-J_{csp} = 50 \text{ mA}$

Verlustleistung

$N_{Vmax} = 50 \text{ mW}^2)$

Sperrschichttemperatur

$\vartheta_{jmax} = 65^\circ \text{ C}$

Wärmewiderstand

$\kappa = 0,4^\circ \text{ C/mW}$

Temperaturbereich

$\vartheta_\alpha = -40 \dots +65^\circ \text{ C}$

¹⁾ Farbkennzeichnung

20 ... 30 rot	40 ... 50 gelb	60 ... 75 blau
30 ... 40 orange	50 ... 60 grün	75 ... 100 violett

²⁾ Gesamte im Transistor auftretende Verlustleistung (Emitter- und Kollektorverlustleistung).

Sie ist abhängig von der Umgebungstemperatur.
s. Bl. OC 816 Seite 5.

Änderungen vorbehalten

FLÄCHENTRANSISTOREN

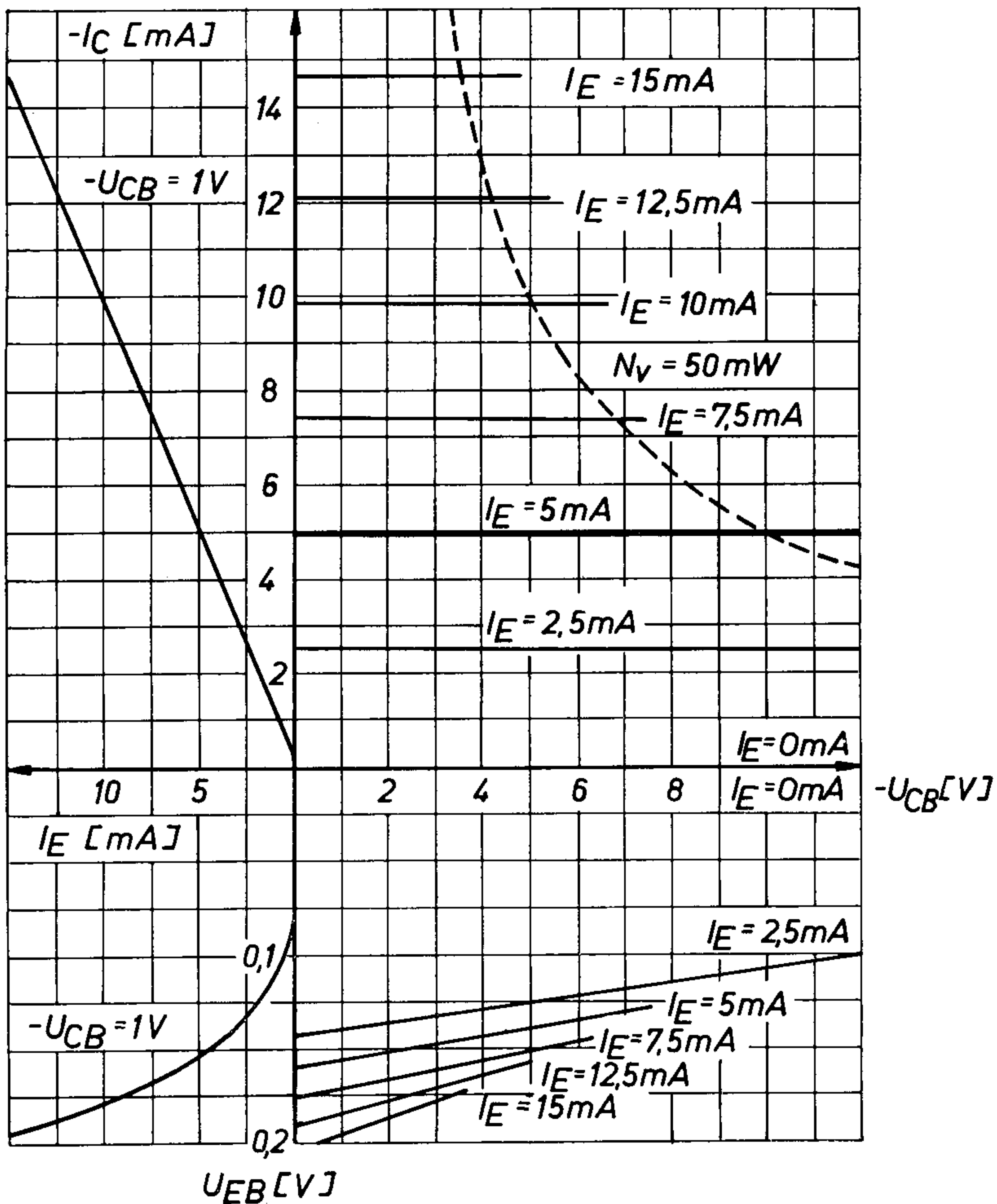
Ausgabe: November 1957

OC 816

p-n-p-Flächentransistor

In Vorbereitung

Kennlinienfeld in Basisschaltung



Änderungen vorbehalten

FLÄCHENTRANSISTOREN

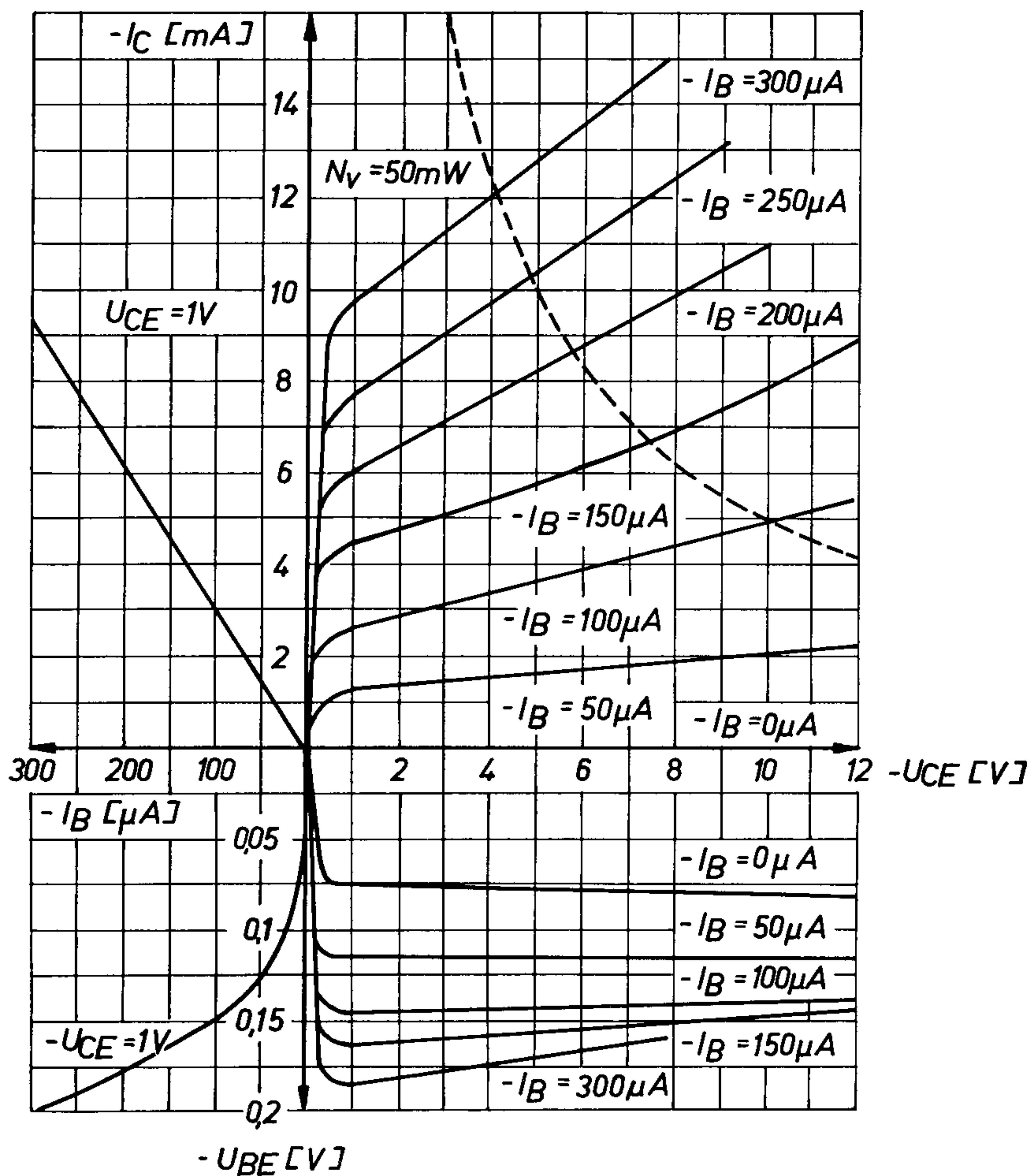
Ausgabe: November 1957

OC 816

p-n-p-Flächentransistor

In Vorbereitung

Kennlinienfeld in Emitterschaltung



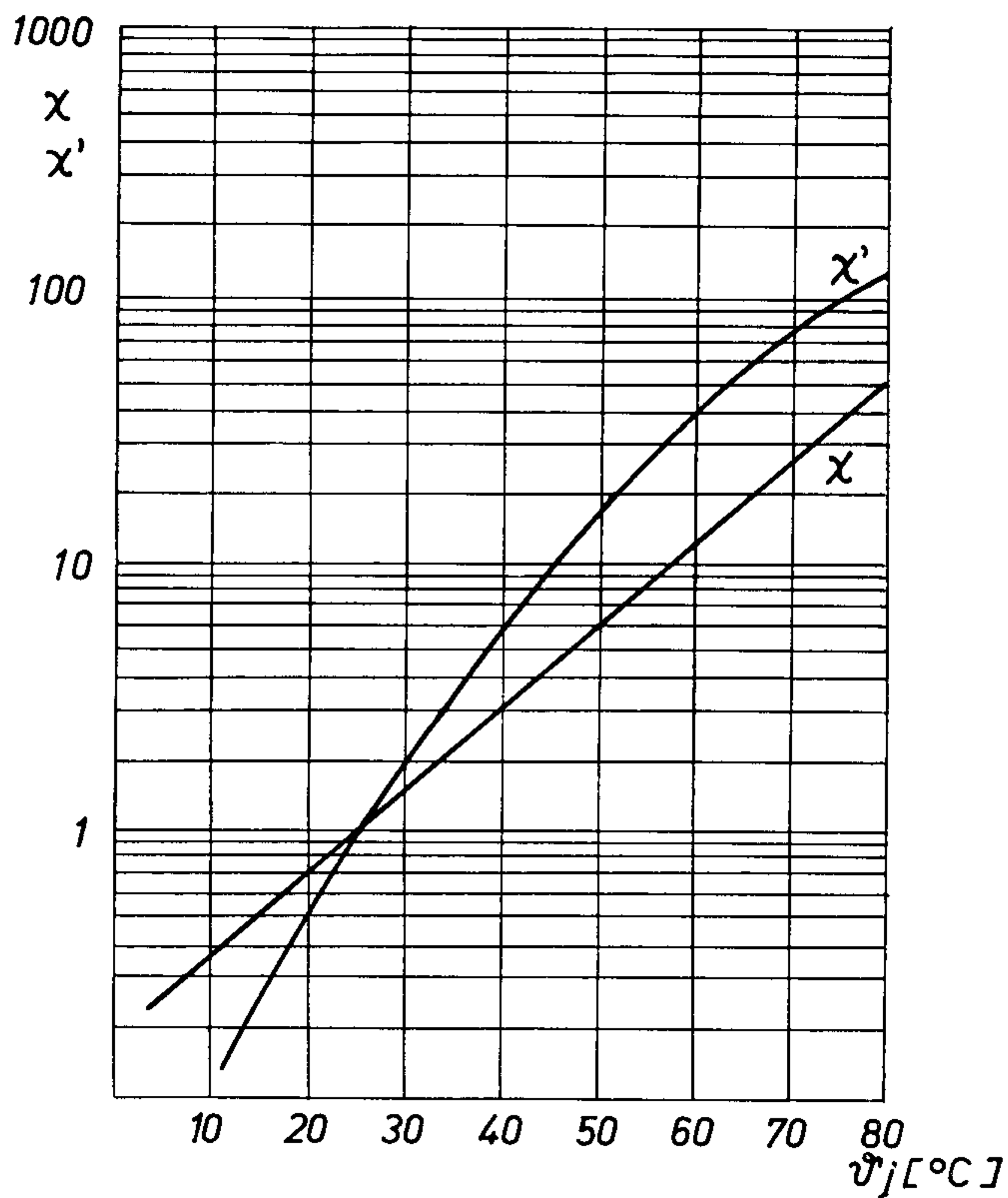
Änderungen vorbehalten

FLÄCHENTRANSISTOREN

Ausgabe: November 1957

OC 815; OC 816
p-n-p-Flächentransistoren
In Vorbereitung

Temperaturabhängigkeit des Kollektorreststromes



$$\chi = \frac{(J_{co})_{\vartheta_j}}{(J_{co})_{\vartheta_j = 25^\circ \text{C}}}$$

$$\chi' = \frac{(J'_{co})_{\vartheta_j}}{(J'_{co})_{\vartheta_j = 25^\circ \text{C}}}$$

Änderungen vorbehalten